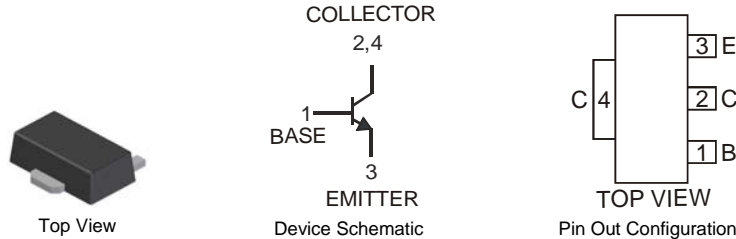


## Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Ideal for Medium Power Switching or Amplification Applications
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**

## Mechanical Data

- Case: SOT89-3L
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.072 grams (approximate)



## Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	15	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	12	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	6	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	6	A
Continuous Collector Current	$I_C$	3	A

## Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_D$	0.9	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	139	$^\circ\text{C/W}$
Power Dissipation (Note 4) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_D$	2	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 4) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	62.5	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_J, T_{STG}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

## Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Conditions
<b>OFF CHARACTERISTICS</b>						
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	15	—	—	V	$I_C = 10\mu\text{A}, I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 5)	$V_{(BR)CEO}$	12	—	—	V	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	6	—	—	V	$I_E = 10\mu\text{A}, I_C = 0$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$	$V_{CB} = 15\text{V}, I_E = 0$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB} = 6\text{V}, I_C = 0$
<b>ON CHARACTERISTICS (Note 5)</b>						
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	90	250	mV	$I_C = 1.5\text{A}, I_B = 30\text{mA}$
DC Current Gain	$h_{FE}$	270	—	680	—	$V_{CE} = 2\text{V}, I_C = 500\text{mA}$
<b>SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS</b>						
Output Capacitance	$C_{obo}$	—	26	—	pF	$V_{CB} = 10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$
Current Gain-Bandwidth Product	$f_T$	—	170	—	MHz	$V_{CE} = 2\text{V}, I_C = 100\text{mA}, f = 100\text{MHz}$

- Notes:
1. No purposefully added lead.
  2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at [http://www.diodes.com/products/lead\\_free/index.php](http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php).
  3. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout.
  4. Device mounted on FR-4 PCB with 1 inch<sup>2</sup> copper pad layout.
  5. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$ .

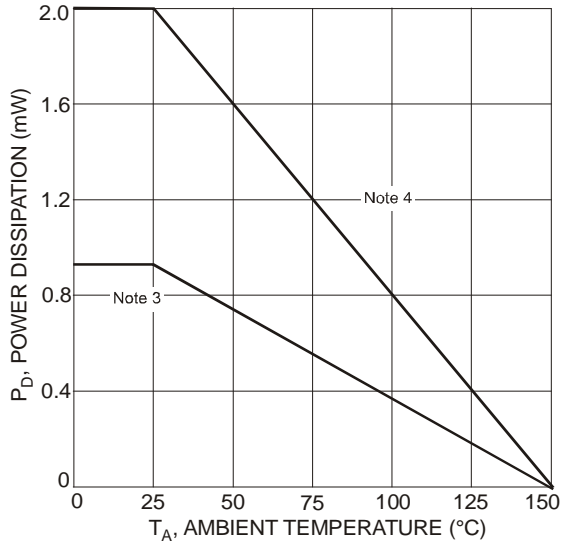


Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature

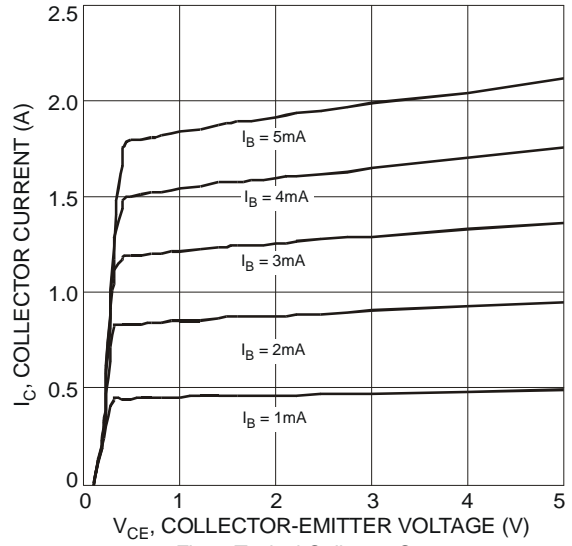


Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage

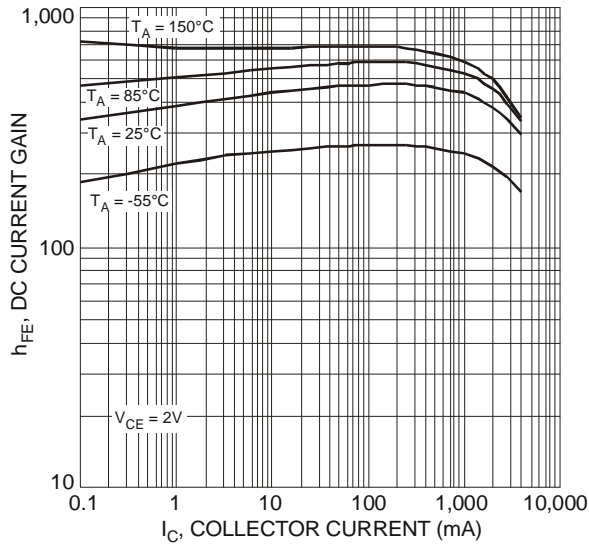


Fig. 3 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

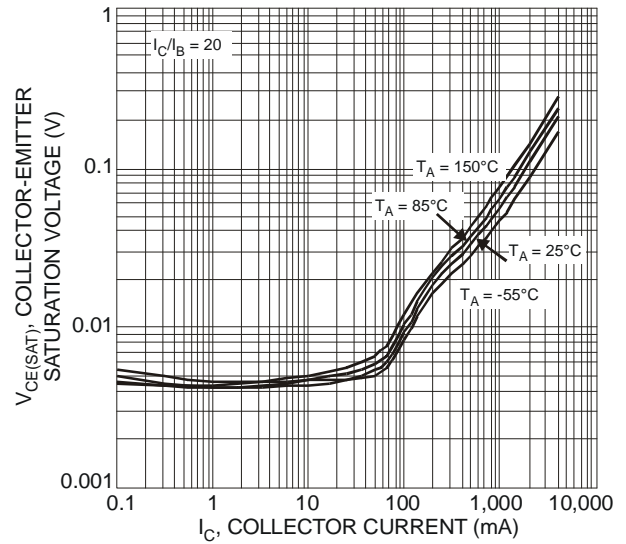


Fig. 4 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

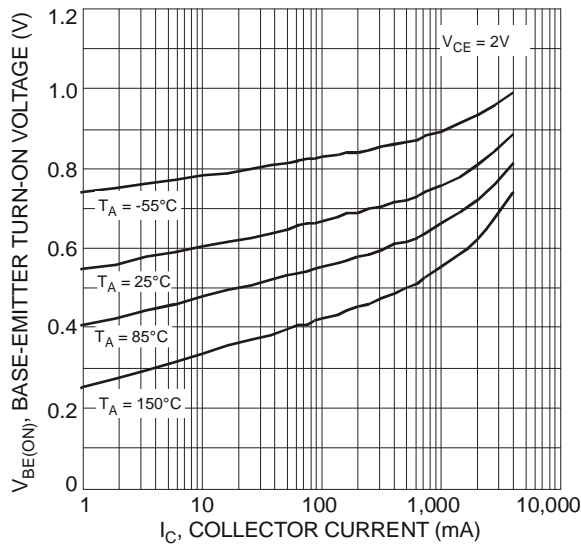


Fig. 5 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

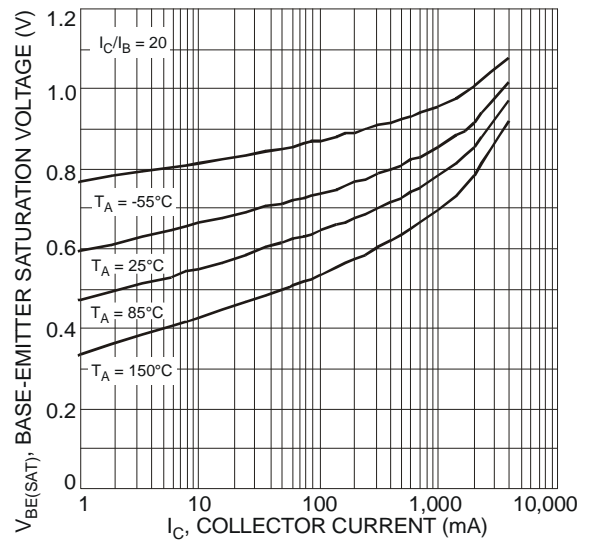


Fig. 6 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

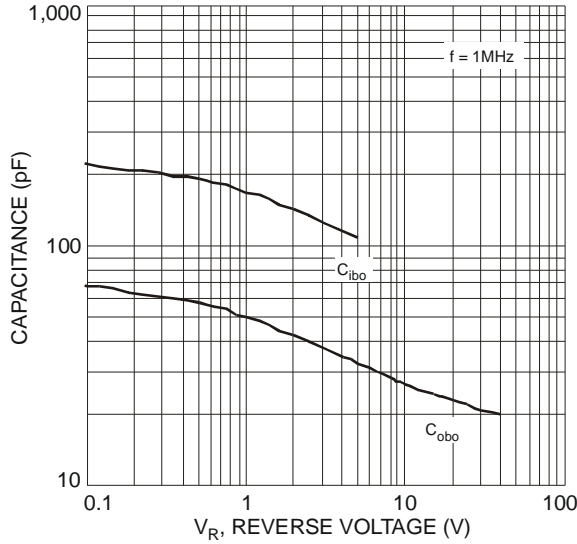


Fig. 7 Typical Capacitance Characteristics

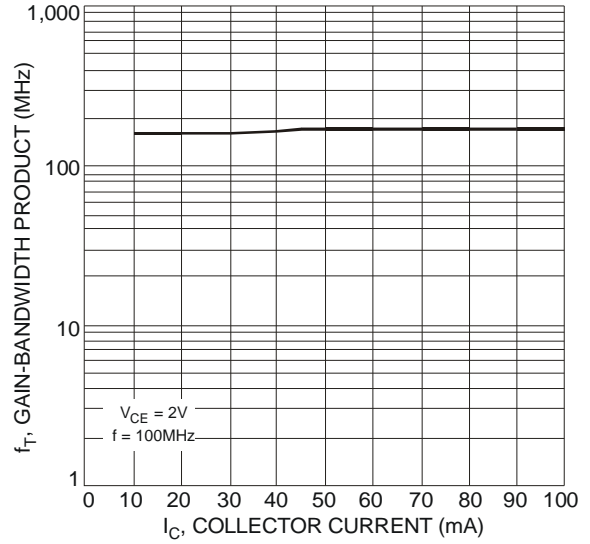


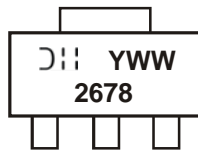
Fig. 8 Typical Gain-Bandwidth Product vs. Collector Current

**Ordering Information** (Note 6)

Part Number	Case	Packaging
2DD2678-13	SOT89-3L	2500/Tape & Reel

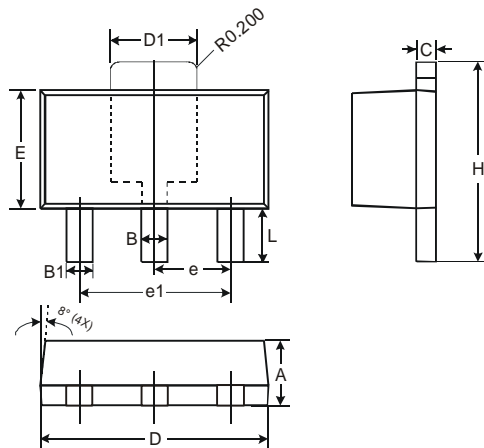
Notes: 6. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

**Marking Information**



2678 = Product Type Marking Code  
 YWW = Date Code Marking  
 Y = Last digit of year (ex: 8 = 2008)  
 WW = Week code (01 – 53)

**Package Outline Dimensions**



SOT89-3L		
Dim	Min	Max
A	1.40	1.60
B	0.44	0.62
B1	0.35	0.54
C	0.35	0.43
D	4.40	4.60
D1	1.52	1.83
E	2.29	2.60
e	1.50 Typ	
e1	3.00 Typ	
H	3.94	4.25
L	0.89	1.20
All Dimensions in mm		



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9